

Specyfikacja zamówienia wsadów do systemu MBE – Riber Compact 21

Wsady:

MBE III – V

Wsad	Masa zamawianego wsadu [kg]	Czystość
Ga	0.1	7N
Al.	0.02	6N5
Si	0.006	>3000 Ohm/cm
As	2.2	7N5

MBE II-VI

Wsad	Masa zamawianego wsadu [kg]	Czystość
ZnTe	0.115	7N
Hg	5.0	9N

Forma zamówionych materiałów – forma odpowiednich rezerwuarów do komór efuzyjnych MBE (crucible).

Przy ładowaniu wsadu do MBE III-V należy pamiętać o wymianie tygla w komórce Al.

Podłoża:

Wsad	Liczba zamawianych podłoży	Parametry:
CdZnTe [211]B 10mmx10mm	25	Rozmiar: 10mmx10mm (± 0.2) Grubość : 800 \pm 50 μ m Orientacja : (112) \pm 0.3 degree Przewodnictwo: Pół-izolacyjne Obróbka powierzchniowa: E.P.D. Nakagawa Trawienie $\leq 1 \times 10^5$ cm ⁻² Obróbka: polerowane, jednostronnie polerowane
GaAs 2" [100]	30	Rozmiar: 2" Grubość : 800 \pm 50 μ m Orientacja : (100) \pm 0.3 degree Przewodnictwo: Pół-izolacyjne Obróbka powierzchniowa: Trawienie E.P.D. Nakagawa $\leq 1 \times 10^5$ cm ⁻² Obróbka: polerowane, jednostronnie polerowane
GaAs 2" [211]B	10	Rozmiar: 2" Grubość : 800 \pm 50 μ m Orientacja : (112) \pm 0.3 degree

		Przewodnictwo: Pół-izolacyjne Obróbka powierzchniowa: E.P.D. Nakagawa Trawienie $\leq 1 \times 10^5 \text{ cm}^{-2}$ Obróbka: polerowane, jednostronnie polerowane
--	--	--

Uchwyty podłoż podczas wzrostów w technologii MBE:

Uchwyt	Średnica zew. w [mm]	Liczba zamawianych uchwytów
Molibdenowy uchwyt do podłoż o rozmiarach 10mm x 10 mm	100	2
Molibdenowy uchwyt do podłoż o rozmiarach 20mm x 20 mm	100	2
Molibdenowy uchwyt ze studzienką kontaktową z Ga dla termopary	100	2